

УДК [548.0 : 53] + 530.145

ФИЗИКА

Г. А. Варданян

Связанное состояние перегибов в квантовом кристалле

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Г. С. Саакяном 26/1 1978)

Состояние квазичастиц в квантовом кристалле классифицируется по значениям квазиимпульса p и соответствующей энергией E (^{1,2}). В том случае, когда речь идет о квазичастицах типа перегибов на дислокациях, расположенных в плоскости скольжения под некоторым углом к кристаллографическим направлениям, согласно теории Анд-реева, зависимость энергии перегиба от одномерного квазиимпульса дается выражением (³).

$$E(p) = E_0 + 2hJ \cos\left(\frac{pa}{\hbar}\right), \quad (1)$$

где E_0 — энергия локализованного перегиба в классическом пределе.

Пусть два перегиба взаимодействуют через потенциал (³) β^2_{xx} , μ — модуль сдвига, $\mu \sim \beta a^{-2}$ и x, x' — дискретные величины. На этот процесс взаимодействия дискретность пространства оставляет яркий отпечаток, в результате возникают своеобразные особенности, которые и рассма-триваются в настоящей работе. Ниже будет показано, что в спектре энергии перегиба возникает локализованный уровень, который отщеп-ляется от зоны. Этот уровень под действием дополнительного возму-щения (малого притяжения) либо сдвигается по отношению границы зоны, либо уширяется, не смещаясь.

Взаимодействия перегибов в дискретном пространстве кристалла описываются уравнением Лифшица (^{4,5}):

$$\sum_x A_{x-x'} \Psi(x') + \sum_x U(x, x') \Psi(x') = Z \Psi(x), \quad (2)$$

где

$$E(p) = \sum_x A_x e^{ipx}. \quad (3)$$

Рассматриваемый потенциал удовлетворяет условию вырожден-ности, т. е. его можно представить в виде произведения двух функ-

ций, зависящих от x и x' . Влияние действия каждой из этих функций на Ψ дает его значение в другой точке.

Исходя из этих рассуждений и используя разложение (3), уравнение (2) запишем в импульсном представлении, интегрируя которое получим:

$$\Psi(x) = \frac{\beta}{2\hbar J} \left(\frac{\sqrt{\epsilon^2 - 1} - \epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 - 1}} \right)^{x/a}, \quad (4)$$

где

$$\epsilon = \frac{E_0 - Z}{2\hbar J}.$$

Спектр энергии определяется соответствующим граничным условием налагаемым на волновую функцию, что дает:

$$1 = \frac{\beta}{V} \int \frac{dp}{\epsilon(p) - Z}. \quad (5)$$

Отсюда следует, что существует отщепленный от зоны уровень Z_0 :

$$Z_0 = E_0 + \Delta \sqrt{1 + \left(\frac{\beta}{\Delta}\right)^2}. \quad (6)$$

С помощью уравнений Дайсона для такого уравня имеем следующую функцию Грива:

$$G_{xx'} = G^0_{xx'} + \frac{\beta G^0_{xx'} G^0_{x'x'}}{1 - \beta G^0}, \quad (7)$$

где

$$G^0 = \frac{1}{\Delta \cdot n} \sum_p \frac{1}{\epsilon - \cos pa - i\delta}. \quad (8)$$

Выражение для $G_{xx'}$ позволяет найти плотность состояний в спектре $\nu(\epsilon)$, которое связано с функцией Грина известным соотношением:

$$\nu(\epsilon) = \frac{1}{\pi n} \text{Im} S_p G(\epsilon)$$

Из выражений (7) и (8) для $\nu(\epsilon)$ имеем:

$$\nu(\epsilon) = \nu_0(\epsilon) + \frac{1}{\pi n} \text{Im} \frac{d}{d\epsilon} \ln \left| 1 - \beta G^0(\epsilon) \right|, \quad (9)$$

где

$$G^0(\epsilon) = \text{Re} G^0(\epsilon) + i \text{Im} G^0(\epsilon). \quad (10)$$

Как следует из выражения (9)

$$1 - \beta \text{Re} G^0(\epsilon) = 0. \quad (11)$$

Это означает, что в некоторой точке плотность состояний увеличивается по отношению к уровням энергии в обычном кристалле. Следовательно, функция $\nu(\epsilon)$ в точке $\epsilon = \pm \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta \cdot n}{\beta}\right)^2}$ имеет максимум.

и вблизи этой точки

$$v(\varepsilon) = v_0(\varepsilon) + \frac{1}{\pi n} \frac{\Gamma_0}{(\varepsilon - \varepsilon_0)^2 + \Gamma_0^2}, \quad (12)$$

где

$$\Gamma_0 = - \frac{i\pi\Delta |\varepsilon_0|}{a \varepsilon_0}$$

ширина этого максимума. Если ε_0 лежит в полосе этого спектра $E(p)$, то эту ситуацию можно трактовать как наличие в системе некоторого виртуального уровня, а в том случае, когда ε_0 лежит вне полосы этого спектра, в системе появляются дискретные уровни, соответствующие связанным состояниям (2,3,8).

Эти состояния, по-видимому, являются аналогами паре квазичастиц, которые могут свободно двигаться только в гексогональной плоскости кристалла (3).

Рассмотрим влияние малого ($v' \ll \beta$) возмущения на локализованное состояние перегиба. Разложим $\det|1 - G^0(E)v'|$ определяющий спектр полюсов в (11) в ряд по степеням v' :

$$\det|1 - G^0v'| = \det|1 - G^0v'| \left[1 - \beta G^0 - \beta \left(\frac{G^0v'G^0}{1 - G^0v'} \right) \right] \quad (13)$$

Пусть $\det|1 - \text{Re}G^0v'| \neq 0$ ни при каких значениях E .

Тогда:

$$v(\varepsilon) = v_0(\varepsilon) + \frac{1}{\pi n} \text{Im} \frac{d}{d\varepsilon} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{Sp} \left[G^0(\varepsilon)v' \right]^k + \\ + \frac{1}{\pi n} \text{Im} \frac{d}{d\varepsilon} \ln \left[1 - \beta G^0(\varepsilon) - \beta \left(\frac{G^0v'G^0}{1 - G^0v'} \right)_{\infty} \right]. \quad (14)$$

Мы видим, что несингулярный вклад порождается дальнедействующей частью v' , а особенности сингулярного вклада определяются уравнением:

$$1 - \beta \text{Re}G^0(\varepsilon) - \beta \text{Re} \left(\frac{1}{1 - G^0v'} G^0v'G^0 \right)_{\infty} = 0. \quad (15)$$

Таким образом, если уравнение (11) имеет решение Z_0 , то возмущение v' приводит к сдвигу этого уровня или дополнительному уширению.

Функция распределения этих перегибов получается решением одномерного уравнения Фокера-Планка, аналогично работе (7):

$$f = - \frac{da^2}{T} f_0 \frac{\varepsilon_a}{da^2 + laF}, \quad (16)$$

где d — коэффициент диффузии ($d \sim \hbar^2/a^2/\beta n$), а $F = v_e \sigma_{em} b_m$. (v — единичный вектор нормали к плоскости скольжения, σ_{em} — тензор напряжений, b_m — вектор Брюггерса), величина f_0 — определяется числом

перегибов $|f_0 \sim |e^{i\pi d/T} - 1|^{-1}|$, а $\varepsilon_d \sim \frac{\pi\Delta}{a}$.

Следовательно, поток равен:

$$j = \frac{1}{f_0} \sum_a i a \varepsilon_a f_a^* = - \frac{\pi^2 d \Delta^2}{T} \sum_a \frac{i}{da^2 - iaF} \quad (17)$$

Следует отметить, что при перемещении перегибов возникает сила торможения, зависящая от скорости движения дислокаций. Величина и зависимость от скорости дислокаций этих сил определяют в основном характер почти стационарного движения.

Объединяя члены с a_n и $-a_n$ из (17) получаем:

$$j = \frac{\pi^2 \Delta^2 d}{T} \sum_n \frac{a_n F}{(da_n^2)^2 + (a_n F)^2}$$

В модели Пейералса (6), максимальная сила определяет те сдвиговые напряжения $\sigma_0 = F_m/a$, которые нужно приложить к кристаллу, чтобы дислокация начала перемещаться в своей плоскости скольжения. Тогда

$$j = \frac{\pi^2 \Delta^2 d}{12Tb} \frac{\sigma_0}{\sigma_0^2 + d^2} \quad (18)$$

где

$$a_n = nb, \quad (n=0, \pm 1, \dots)$$

Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность И. М. Лифшицу и А. Ф. Андрееву за полезные советы.

Ереванский государственный университет

Գ. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Շրջման կետերի կապված վիճակները Բվանտային բյուրեղում

Գիտարկված է միաչափ բվանտային բյուրեղում դիսլոկացիաների վրա շրջման կետերին համապատասխանող բվագիմասանիկների վարքը Ցույց է տրվում, որ բյուրեղի համաչափության առանցքի ուղղությամբ առաջանում են լոկալիզացված էներգետիկ մակարդակներ, որոնք համապատասխանում են կապված վիճակների առաջացմանը: Լրացուցիչ փոքր զրպոումը բերում է այդ մակարդակի կամ շեղմանը կամ լայնացմանը: Այդպիսի բվագիմասանիկների դույզը կարող է շարժվել միայն որոշակի ուղղությամբ, որը բնութագրվում է սիմուլյացիայի դորժակցով:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ А. Ф. Андреев, И. М. Лифшиц, ЖЭТФ, 56, 2057 (1969) ² R. A. Guyer, L. I. Zane, Phys. Lett. 24, 650 (1970). ³ А. Ф. Андреев, УФН, 118, 251 (1966). ⁴ И. М. Лифшиц, Nuovo Cim. suppl, 3 716 (1956). ⁵ И. М. Лифшиц, Г. А. Вардьян, ДАН Ари. ССР т. LXI, № 3 (1976). ⁶ А. М. Кочевич, Основы мехзники кристаллической решетки, М. 1972. ⁷ А. Ф. Андреев ЖЭТФ, 67, 1559 (1974).